

本區機台現有的標準製程：

本機台現有之標準製程建立，原則上以廠務端供應之化學藥品進行調配；小型試片之處理則以NDL 無機化學藥品庫房所供應之藥品為調配依據。

金屬材料	使用化學品	濃度	溫度
Co	H ₂ SO ₄ : H ₂ O ₂	3:1	120°C
Al	H ₂ SO ₄ : H ₂ O ₂	3:1	120°C
Ni	H ₂ SO ₄ : H ₂ O ₂	3:1	120°C
Ti/Al	H ₂ SO ₄ : H ₂ O ₂	3:1	120°C
光阻	Pure H ₂ SO ₄	1:0	120°C
SiN _x	H ₃ PO ₄	100%	150°C
SiO _x	BOE(7:1)	任意比例	室溫

1. 硫酸槽及磷酸槽 (H₂SO₄ 96% : H₂O₂ 31% / H₃PO₄ 86%)
用途：進行金屬薄膜移除及光阻去除/氮化矽薄膜蝕刻。
2. 二氧化矽蝕刻液 (B. O. E. 7:1 → HF:NH₄F)
用途：凡屬後段製程之二氧化矽 (SiO₂) 圖形之蝕刻或移除。